

ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ МИКРОЭЛЕКТРОНИКА – 2021 г.

ЧАСТЬ 1. БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ ГОД ДЛЯ МИРОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

ДМИТРИЙ БОДНАРЬ, к. т. н., генеральный директор,
АО «Синтез Микроэлектроника»



Мировая пандемия COVID-19 оказала сильное влияние на результаты минувшего 2021 г., в т. ч. на рынок и развитие мировой электронной промышленности. Главным стал тотальный дефицит полупроводниковых изделий, отразившийся на всей мировой экономике и особенно на автомобильной промышленности. Повышенный спрос на электронные компоненты способствовал увеличению частных и государственных инвестиций в электронику, расширению и созданию новых производств, значительному росту мирового полупроводникового рынка, впервые преодолевшего рубеж в 500 млрд долл. Побочными итогами стали сильный рост цен на электронные товары и материалы, увеличение сроков поставок, нехватка квалифицированных кадров и рост общемировой инфляции.

ДЕФИЦИТ ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ. МИРОВАЯ ОТРАСЛЬ ВКЛЮЧИЛА ФОРСАЖ, БЬЕТ РЕКОРДЫ, НО НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ

2021 г. оказался уникальным для мировой электронной промышленности. Никогда еще за всю ее историю мир не ставился со столь очевидным и значительным дефицитом электронных компонентов, ростом цен на них и применяемые материалы, а также с нехваткой производственных мощностей для их выпуска. Согласно прогнозу ассоциации WSTS, темпы роста мирового полупроводникового рынка в 2021 г. составят 25,1% (см. табл.) [1], что является вторым показателем с 2001 г. Только однажды в 2010 г. рост был более заметным и составил 26% (см. рис. 1) [2].

WSTS скорректировала свой предыдущий прогноз, опубликованный всего несколько месяцев до этого, где указывался более скромный темп роста величиной 19,7%. Большой рост

в 2010 г. был связан с эффектом низкой базы из-за существенного спада рынка на 9% во время мирового экономического кризиса в 2008–2009 гг. Объем мирового полупроводникового рынка в 2021 г. достигнет рекордных показателей и составит 550 млрд долл., впервые в истории отрасли превысив этот рубеж.

Вероятно, в начале 2022 г. после уточнения фактических отраслевых показателей за прошедший год эта величина скорректируется, и темпы роста в минувшем году станут лучшими за последние 20 лет. Рост происходит во всех мировых регионах в отношении продукции всех типов, что наблюдается в мировой полупроводниковой промышленности не так часто. Максимальным (на 37,1%) станет рост в сегменте микросхем памяти, в котором два года назад наблюдалось падение.

Очевидно, что столь высокие темпы роста связаны с существенным дефицитом электронных компонентов в 2021 г. Они

Таблица. Прогноз мирового полупроводникового рынка за период 2021–2022 гг. от ассоциации WSTS

	Сумма, млрд долл.			Изменения год/год, %		
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Америка	95,366	115,868	129,773	21,3	21,5	12,0
Европа	37,520	47,440	51,138	-5,8	26,4	7,8
Япония	36,471	42,913	45,893	1,3	17,7	6,9
Азиатско-Тихоокеанский регион	271,032	344,656	379,678	5,1	27,2	10,2
Итого в мире, млрд долл.	440,389	550,876	606,482	6,8	25,1	10,1
Дискретные п/п приборы	23,804	29,389	30,936	-0,3	23,5	5,3
Оптоэлектроника	40,397	43,137	44,967	-2,8	6,8	4,2
Сенсоры	14,962	18,666	19,790	10,7	24,8	6,0
Интегральные микросхемы	361,226	459,685	510,788	8,4	27,3	11,1
Аналоговые	55,658	71,882	76,757	3,2	29,1	6,8
Микропроцессоры	69,678	77,305	80,922	4,9	10,9	4,7
Логические ИС	118,408	149,388	162,341	11,1	26,2	8,7
Память	117,482	161,110	190,769	10,4	37,1	18,4
Итого по всем изделиям, млрд долл.	440,389	550,876	606,482	6,8	25,1	10,1

Примечание. Цифры в таблице округлены до целых значений в млрд. долл., из-за чего могут возникать небольшие несоответствия в полях «Итого» по типам изделий и регионам.

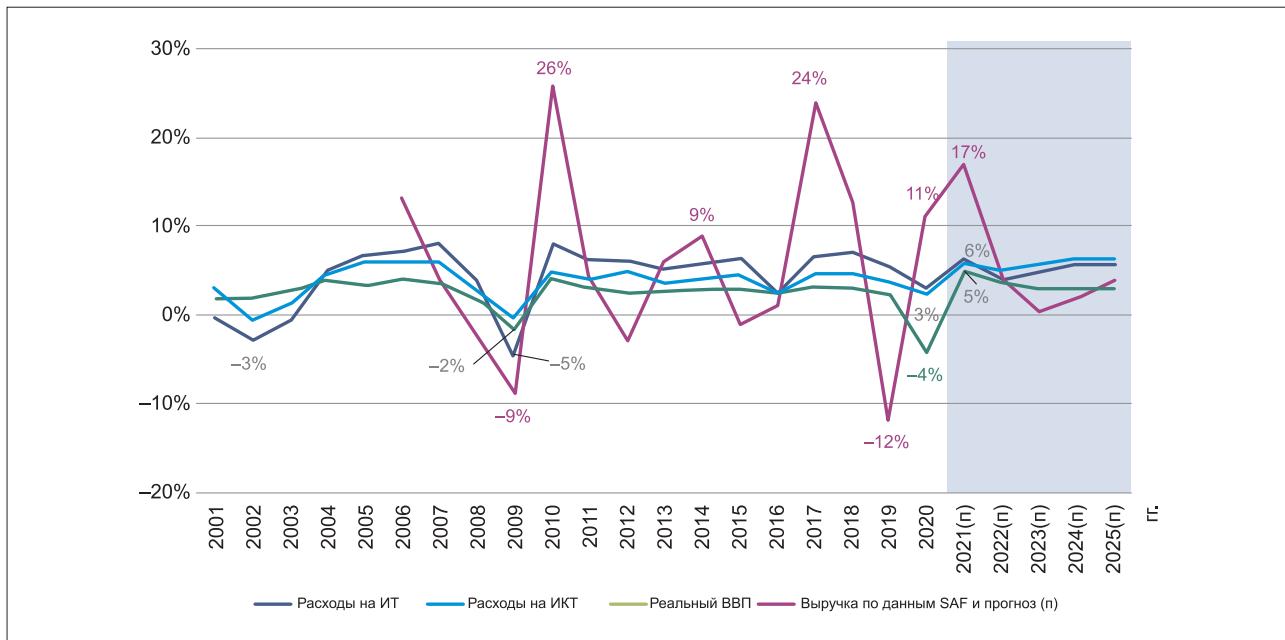


Рис. 1. Темпы изменения мирового полупроводникового рынка за 2001–2025 гг.

стали бы заметнее, если бы мировая полупроводниковая промышленность была в состоянии обеспечить производство всей заказываемой продукции. В 2022 г. организация WSTS также предполагает дальнейший подъем мирового полупроводникового рынка на 10,1% до 606 млрд долл.

Компания IC Insights представила отчет по мировому рынку группы оптоэлектроники, датчиков и дискретных продуктов (O-S-D) (см. рис. 2) [3]. Ожидается, что мировые продажи в 2021 г. вырастут на 18% до 104,3 млрд долл. с 88,3 млрд долл. в 2020 г., когда эта группа рынка полупроводников увеличилась менее чем на 3%. O-S-D-изделия обеспечивают около 18% мировых продаж полупроводников, а остальная их часть (82%) приходится на интегральные схемы.

25 лет назад на продукцию O-S-D приходилось менее 13% доходов от производства полупроводников. Рыночная группа O-S-D с середины 1990-х гг. постепенно обеспечивала постоянно увеличивавшуюся долю доходов от полупроводников из-за стабильного и часто значительного ежегодного роста производства датчиков, приводов, КМОП датчиков изображения, лазерных передатчиков и светодиодов высокой яркости.

Этому способствовали увеличение выпуска смартфонов, оснащенных цифровыми камерами и датчиками, а также высокоскоростная связь, интернет вещей (IoT) и недавний рост приложений искусственного интеллекта (ИИ), встраиваемых в большее количество систем. Ожидается, что в 2021 г. выручка от дискретных полупроводников после небольшого роста менее чем на 3% в 2020 г. (до 27,8 млрд долл.) вырастет

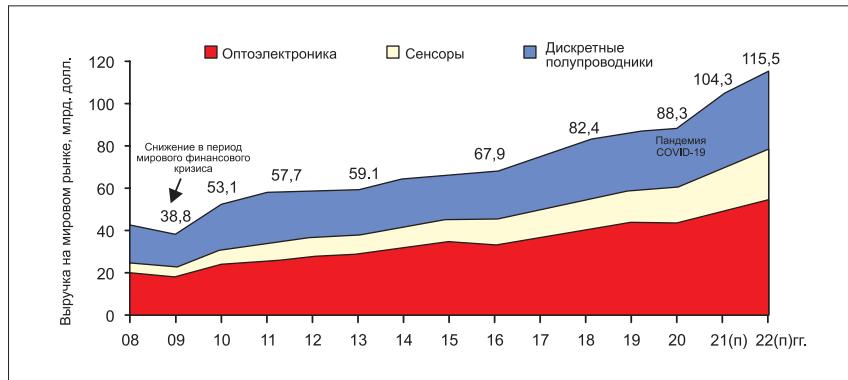


Рис. 2. Мировой рынок оптоэлектроники, датчиков, дискретных полупроводников за 2008–2022 гг.

примерно на 26% до 35,0 млрд долл., что станет четвертым среди самых больших годовых темпов роста за последние 40 лет в этом сегменте полупроводников. Согласно прогнозу IC Insights, в 2022 г. общий объем продаж изделий O-S-D вырастет на 11% до 115,5 млрд долл.

Нехватка электронных компонентов в минувшем году сопровождалась торжествием развития многих отраслей мировой промышленности, и, в первую очередь, автомобильной. Этот дефицит тайфуном прошелся не только по всем мировым автопроизводителям, останавливавшим конвейеры и снижавшим выпуск автомобилей, но разрушил бизнес небольших и средних компаний смежников, поставлявших комплектующие и оборудование для автопрома.

Так, пять компаний в Германии – основном европейском производителе автомобилей, выпускающих кузовные пресс-формы и комплектующие, заявили о банкротстве и неплатежеспособности из-за снижения заказов автопромом [4]. Причинам дефицита электронных компонентов посвящено немало аналитических материалов, но основными среди

этих причин являются три: продажа и опустошение складов производителей и потребителей компонентов во время мирового локдауна; резко возросшая потребность в электронике для возобновивших работу производств и пополнения складских запасов после его окончания; повышенный ажиотажный спрос из-за увеличения сроков поставки и отказов поставщиков.

Для гарантированного исполнения заказов даже крупные покупатели стали предлагать предоплату, что прежде не практиковалось. Все остальные причины, включая сложные климатические условия и катастрофы в США, Тайване, Японии, важны, но не являются определяющими и в разной степени происходили прежде.

Генеральный директор Apple Тим Кук оценил потери своей компании от отсутствия микросхем в 6 млрд долл. [5]. Эксперты компании AlixPartners уже третий раз за год пересматривают свой прогноз по мировому автомобильному рынку. В новейшей версии он гласит, что объемы выпуска автомобилей в 2021 г. сократятся на 7,7 млн шт., а потери авто-

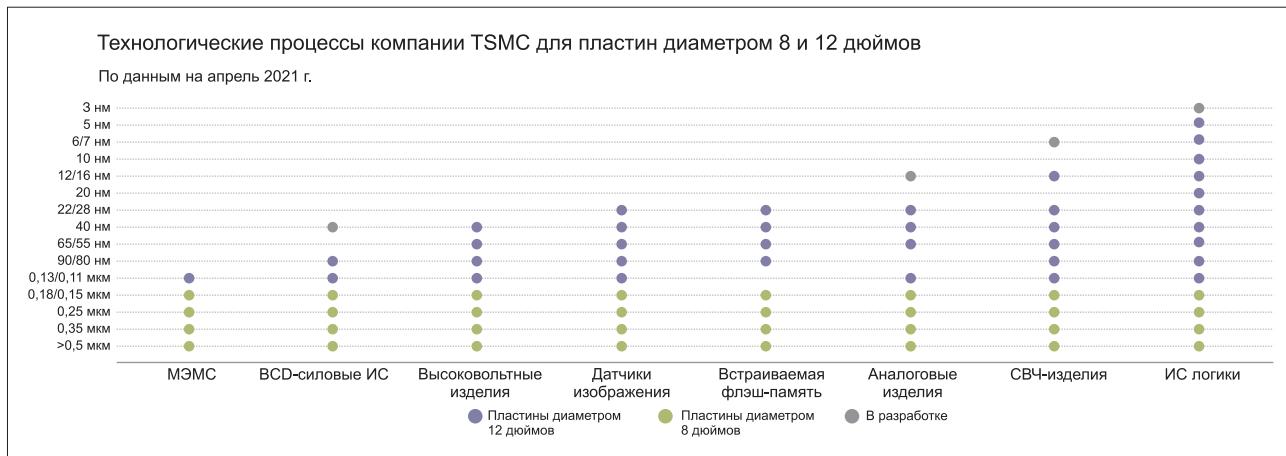


Рис. 3. Диаметр пластин для разных технологий компании TSMC

производителей из-за нехватки полупроводниковых компонентов достигнут 210 млрд долл. [6]. Еще в мае аналитики AlixPartners рассчитывали на снижение выручки автопроизводителей на 110 млрд долл. по итогам текущего года, а потери в натуральном выражении прогнозировали на уровне 3,9 млн автомобилей, которые не смогут быть выпущены из-за дефицита чипов.

Теперь оба показателя увеличились почти в два раза. Производители полупроводниковых компонентов для автопромышленности NXP, Texas Instruments, Infineon, ON Semiconductor, Microchip резко повысили срок исполнения заказов с 12 недель в 2020 г. до 21,7 недель к сентябрю 2021 г. [7]. Однако даже эти сроки не соблюдаются.

Самые большие потери из-за нехватки электронных компонентов понесут Ford (падение выпуска в 2021 г. – 700 тыс. автомобилей), Stellantis (марки Fiat, Citroen, Chrysler, Dodge, Jeep – падение на 600 тыс.) и альянс Renault-Nissan-Mitsubishi (падение на 415 тыс.). В компании Stellantis заявили, что потери от дефицита полупроводников оказались существенно выше, чем от пандемии и остановки заводов в 2020 г.

Высокий спрос на электронные компоненты в 2021 г. привел к перераспределению производственных мощностей на фабриках производства пластин и чипов. До 2019 г. увеличивалась их производительность на пластинах диаметром 300 мм для новых современных процессов и, наоборот, падала для 200-мм пластин на фабриках по зрелым технологиям. Этому способствовали новые изделия для смартфонов, внедрение 5G, технологии управления электропитанием и т. д. В результате ведущие мировые производители чипов TSMC, UMC и др. наращивали мощности производства на основе 300-мм, а не 200-мм пластин.

Так, компания TSMC использует 300-мм пластины для технологий 130 нм и менее (см. рис. 3) [8], хотя у многих других фабрик переходными являются технологии 65–90 нм. Несмотря на то, что исходные 200-мм пластины значительно дешевле 300-мм, экономические показатели себестоимости чипов на 300-мм пластинах лучше.

Еще одной проблемой для компаний, эксплуатирующих фабры с оборудованием для 200-мм пластин, является то, что производители оборудования потеряли интерес к 200-мм производству и массово переориентировались на оборудование для обработки 300-мм пластин. Как правило, оборудование для 300-мм пластин позволяет обрабатывать и 200 мм, но стоимость его значительно выше и использовать его для меньшего диаметра экономически невыгодно.

Таким образом, даже не ведущие фабрики чипов стали переводить их на 300-мм пластины. Это затронуло не только технологии менее 110 нм, но даже производство некоторых дискретных приборов. Так, например, китайская компания Hua

Hong Semiconductor впервые в мире переводит производство транзисторов Trench FS IGBT в городе Уси с 200- на 300-мм пластины [9]. В результате уже с 2019 г. стала ощущаться нехватка производственных мощностей для 200-мм пластин. Пандемия и тотальный дефицит электронных компонентов только усугубили проблему, а контрактные производители чипов TSMC, UMC, SMIC увеличили инвестиции в производство по зрелым техпроцессам [10]. Китайский полупроводниковый лидер SMIC инвестирует 8,87 млрд долл. в строительство новой фабрики в Шанхае производительностью 100 тыс. 300-мм пластин в месяц по 28-нм технологиям.

Значительный рост полупроводникового рынка привел к увеличению заказов кремниевых пластин, их дефициту, удлинению сроков поставки и, как следствие, к росту цен на них. Согласно прогнозам SEMI, глобальные поставки кремниевых пластин будут стабильно расти до 2024 г.; при этом суммарная площадь пластин увеличится на 13,9% в годовом исчислении в 2021 г. до рекордного уровня почти в 14 000 млн кв. дюймов [11]. Ожидается, что в последующие годы импульс роста сохранится, но его можно сдержать замедлением темпов макроэкономического восстановления и сроками добавления мощностей по производству пластин, необходимых для удовлетворения растущего спроса.

Увеличение производственных мощностей, запуск новых заводов и производственных линий привел к сильному росту инвестиций и затрат на полупроводниковое оборудование для фабрик чипов. В 2021 г. они достигнут нового рекорда и превысят 90 млрд долл. при темпах роста 44%, но уже в 2022 г. пре-взойдут этот рекорд и вырастут еще на 8% почти до 100 млрд долл. (см. рис. 4) [12]. На рынке поддержанного оборудования также резко возрос спрос, вследствие чего запасы оборудования на вторичном рынке сильно истощены и сроки его продаж, особенно для 200 мм, резко сократились.

TrendForce прогнозирует, что общая емкость производства 200-мм пластин в отрасли будет расти со среднегодовым темпом 3–5% с 2019 по 2023 гг., тогда как емкость 300-мм пластин будет увеличиваться в среднем в год на 11–13% за тот же период [13]. Несколько контрактных производителей, включая SMIC, занимаются расширением своих 28-нм производственных мощностей, в первую очередь, потому, что транзисторная архитектура ниже 20 нм требует перехода с Planar FET на архитектуру FinFET, что обходится относительно дорого. TrendForce считает, что 28-нм техпроцесс представляет собой золотую середину по соотношению цена/качество и широко используется для производства таких основных продуктов как чипы Wi-Fi для ноутбуков, микросхемы OLED-драйверов для смартфонов, автомобильные микроконтроллеры и процессоры сигналов изображения.

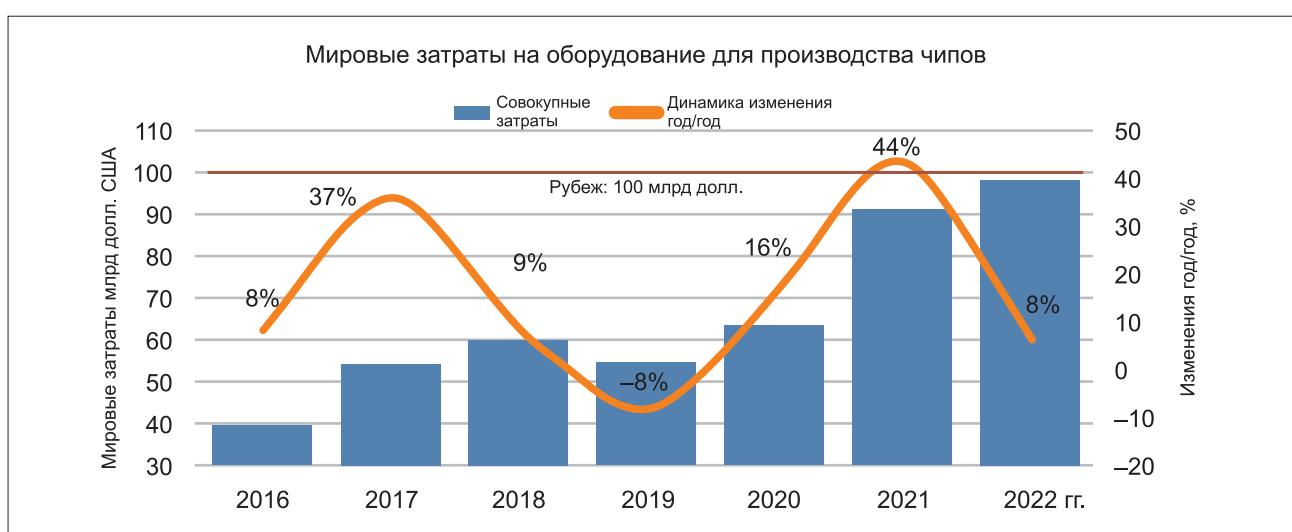


Рис. 4. Мировой рынок расходов на оборудование для производства чипов за период 2016–2022 гг.

Кроме того, микросхемы, используемые для интернета вещей, включая умную бытовую технику и телевизионные приставки, а также другие изделия, которые в настоящее время производятся по технологии 40 нм, вероятно, будут переведены на 28-нм производство, а это значит, что спрос на емкость 28 нм продолжит расти в будущем.

Прогнозы центра исследований ReportLinker по мировому рынку полупроводниковой промышленности крайне оптимистичные. Ожидается, что за период с 2021 по 2026 гг. среднегодовые темпы роста составят 7,7%, а объем рынка к 2026 г. достигнет впечатляющего показателя – 778 млрд долл. [14]. Основными драйверами этого рынка являются увеличение цен на полупроводники из-за нехватки предложения, рост беспроводной связи, спрос на передовые функции безопасности в автомобилестроении и увеличение числа подключенных к интернету устройств, спрос на полупроводники в искусственном интеллекте и в технологиях автономного вождения. Компания IC Insights прогнозирует рост поставок микросхем с 2020 по 2025 гг. при среднегодовом темпе 11%, тогда как за период с 2015 по 2020 гг. этот показатель составил 6% [15]. Снижение поставок микросхем – редкое явление в мировой микроэлектронике. Оно наблюдалось всего пять раз: в 1985, 2001, 2009, 2012 и 2019 гг. и ни разу не длилось два года подряд.

TSMC МЕНЯЕТ СТРАТЕГИЮ. ДРУГИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ГРАНДЫ АКТИВНО СТРОЯТ НОВЫЕ ФАБРИКИ

2021 г. окончательно ознаменовался изменением дальннесрочной стратегии действий ведущего мирового контрактного производителя чипов – компании TSMC. До текущего года при расширении производственных мощностей (иногда даже носивших авральный характер) TSMC всегда ориентировалась на Тайвань и отказывалась от производственной экспансии в другие страны, в т. ч. в США. Из 13 фабрик производства чипов TSMC имеет только по одной 300-мм и 200-мм фабрике в континентальном Китае и одну на 200 мм в США [16]. Все четыре вспомогательных фабрики сервиса backend также расположены на Тайване.

Однако с 2019–2020 гг. компания начала менять многолетнюю стратегию. Вначале под давлением США тайваньский лидер согласился на строительство в стране не одного, а нескольких заводов по самым современным технологиям 5–7 нм. Затем пошел поток сообщений о проведении переговоров о строительстве новых производств TSMC в Японии и Германии [17–18].

Этот прорыв вызван несколькими причинами. Исходной являются санкционные ограничения правительства США

в противостоянии с Китаем. Но это не главное. TSMC за последнее десятилетие является самой динамично развивающейся мировой полупроводниковой компанией. Если в 2010 г. ее годовые объемы продаж составляли 13,37 млрд долл. [19], то теперь таких объемов компания достигает всего за один квартал [20]. Подобных темпов роста при таких объемах не имеет ни одна крупная полупроводниковая компания мира.

Доля TSMC в мировом объеме контрактных производителей чипов постоянно росла и достигла 55%. В этом и кроется большая ловушка для мировой отрасли, приобретающей хроническую зависимость от тайваньского гиганта. Постоянное расширение и строительство новых современных производств на острове Тайвань давно стало сталкиваться с трудностями, обусловленными не финансовыми причинами. Первой среди них являются энергетические ограничения.

Такие производства требуют большого потребления электроэнергии, воды и других энергоносителей. Нехватка электроэнергетических мощностей, повышенная сейсмическая и климатическая зависимость острова от погодных аномалий являются еще одним фактором, ставящим под угрозу стабильную работу предприятий полупроводникового гиганта на Тайване. TSMC также давно сталкивается с кадровыми проблемами и нехваткой квалифицированных кадров даже на действующих предприятиях на острове.

На вновь строящихся фабриках кадровая проблема станет намного острее. Хотя с подобной проблемой в настоящее время сталкивается в США и процессорный гигант Intel, вынужденный даже привлекать студентов младших курсов для работы на своем заводе в шт. Орегон [21]. Разница в том, что у Intel это отчасти временная проблема, связанная с ростом производства из-за дефицита электроники, а у TSMC – хроническая. Не последнюю роль в этом играет континентальный Китай, переманивающий высокими зарплатами квалифицированных специалистов из Тайваня.

Бурный рост полупроводникового производства и создание новых предприятий во всех странах, где эта отрасль является профилирующей, потребует большого дополнительного количества квалифицированных кадров, что сопряжено с их повышенной миграцией из регионов, где микроэлектроника не является ведущей отраслью, в т. ч. из России. Поэтому в ближайшие годы следует ожидать их оттока из нашей страны, которая сама испытывает трудности с нехваткой опытных и мобильных специалистов, особенно молодых.

Таким образом, производственная экспансия за пределы Тайваня давно стала необходимостью. Без этого внутренние проблемы каждого нового завода на острове постепенно начнут разрушать его изнутри. Каждая такая проблема и оста-

новка завода гулким эхом отзовется не только на состоянии компании, но и всей мировой отрасли. Руководство TSMC это отчетливо понимает, принимая решение об изменении долгосрочной стратегии по экспансии за пределы Тайваня.

В то же время основатель TSMC Моррис Чанг (Morris Chang), ушедший в отставку в 2018 г., выступил с критикой американских властей по достижению национального суверенитета, утверждая, что выделяемых правительством США средств в размере 52 млрд долл. недостаточно для этого [22]. Скорее всего, эта критика направлена в сторону текущего руководства TSMC, поменявшего стратегию, которую Моррис Чанг проводил во время своего руководства компанией. Он считает, что воссоздать полную цепочку поставок компонентов и их производство на территории США обойдется в сотни миллиардов долларов и в конечном итоге их себестоимость окажется настолько высокой, что вся затея потеряет смысл.

По мнению автора статьи, Моррис Чанг прав только в том, что этих средств правительства не хватит для достижения цели. Однако проект ими и не ограничивается. Значительную долю необходимых инвестиций внесут правительство США, местные штаты и сами компании. Что касается всей цепочки материалов и логистики, то производители материалов уже разворачивают предприятия в США для локализации. К тому же, для достижения национального суверенитета главным является запуск суперсовременных фабрик производства чипов. На первых порах материалы могут поставляться из-за пределов США. Смежники сами будут заинтересованы в строительстве заводов в США, поскольку этот рынок для них крайне перспективный. Безусловно, стоимость производства в США может оказаться выше, чем на Тайване за счет более высоких зарплат и налогов, но текущие льготные программы правительства и штатов после начала производства на этом не закончатся.

Еще одним подтверждением новой стратегии TSMC является объявленное компанией решение о планах строительства своей первой в Японии фабрики по производству чипов по 22–28-нм технологиям, начало работы которой запланировано на конец 2024 г. [23]. Для этого TSMC создает в Японии дочернюю компанию JASM с участием в качестве миноритарного акционера компании Sony Semiconductor, инвестирующей в нее 0,5 млрд долл.

Строительство фабрики при активной поддержке правительства Японии с первоначальными затратами 7 млрд долл. производительностью 45 тыс. 300-мм пластин в месяц для выпуска чипов датчиков изображения начнется в 2022 г. Не вызывает сомнения, что несмотря на получение субсидий от правительства США и Японии, структура затрат на производство на этих фабриках будет выше, чем на Тайване.

В отличие от существующих старых фабрик, где оборудование уже амортизировано, стоимость нового на строящихся фабриках будет существенно выше. Эти затраты производители станут перекладывать в цены на продукцию. Тем более что, как заявило руководство TSMC, затраты на фабрику в США будут намного выше, чем предполагалось [24].

По оценкам Micron, затраты на производство памяти в США на 35–45% выше, чем на более дешевых рынках с устоявшимися полупроводниковыми экосистемами [25]. В первой половине текущего года Micron сообщила о продаже компании Texas Instruments 300-мм фабрики в Лехи (шт. Юта), которая была куплена у Intel в 2019 г. в рамках совместного предприятия по производству памяти 3D XPoint [26]. Micron планирует построить новый завод на территории своего производственного комплекса в Японии и инвестировать в него порядка 800 млрд юаней (7 млрд долл.) [27]. Предполагается, что предприятие с 2024 г. будет выпускать чипы оперативной памяти для серверного оборудования ЦОД и персональных компьютеров.

В начале 2020 г. Texas Instruments (TI) сообщала о планах окончательного закрытия двух своих старых фабрик в Шер-

мане и Далласе (шт. Техас), являющихся единственными заводами компании, который работают с пластинами диаметром 150 мм [28]. Однако дефицит электроники привел к коррекции планов – на месте этих предприятий построят новые заводы для 300-мм пластин. Строительство в Шермане с первоначальными инвестициями в 6,5 млрд долл. начнется в 2022 г., а выпуск продукции запланирован с 2025 г. [29]. Общий размер инвестиций компании на протяжении четырех этапов составит 23,4 млрд долл. Новые фабрики дополнят существующие 300-мм фабрики TI DMOS6 (Даллас), RFAB1 и RFAB2, которые скоро будут завершены (обе в Ричардсоне, шт. Техас). Производство на них, как ожидается, начнется во 2-й половине 2022 г. Кроме того, ожидается, что производство LFAB (Лехи, шт. Юта), недавно приобретенное TI, стартует в начале 2023 г. [30].

РОСТ ЦЕН НА ЭЛЕКТРОНИКУ – ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Глава Infineon Рейнхард Плосс (Reinhard Ploss) полагает, что производители компонентов должны будут оправдать инвестиции, направленные на увеличение объемов выпуска полупроводниковых изделий из-за повышения спроса на них, что приведет к дальнейшему значительному увеличению цен [31].

В 2021 г. увеличилась стоимость поликристаллического кремния, а поставщики кремниевых слитков и пластин повышают их цену на 20% [32]. От повышения цен крупные полупроводниковые компании пока страхуют долгосрочные контракты с поставщиками кремния, но с началом 2022 г. цены пластин неминуемо повысятся и, вероятно, не один раз. Стоимость фотомасок увеличилась на 20% в этом году. Спрос на них в полной мере тоже не удовлетворен, поскольку их комплексы многоразовые, а многие уже изготовлены. Себестоимость изготовления чипов в 2021 г. выросла до 30%.

Все это неминуемо будет сопровождаться ростом цен на продукцию и услуги в 2022 г., а дальнейшее изменение цен будет зависеть от конъюнктуры на мировых рынках. При снижении дефицита электронных компонентов, заполнении складов и падении текущего ажиотажа автор допускает возможность снижения цен в 2023–2024 гг. на продукцию и услуги по зреющим и старым технологиям, где высокая конкуренция.

Однако в сегменте самых передовых технологий менее 10 нм возможен дальнейший рост цен из-за отсутствия полноценной рыночной конкуренции всего трех мировых производителей (TSMC, Samsung, Intel). Похоже, заказчики готовы платить больше, а в погоне за принятие своих заказов и включение их в производственные планы поставщиков в 2021 г. заказчики стали предлагать предоплату за продукцию, что ранее не практиковалось. Очевидно, в следующем году этот конкурс покупателей продолжится.

В поддержку роста цен будет направлена и общемировая инфляция и повышение цен на многие товары, включая продовольствие, металлы, энергоносители, обозначившиеся в 2021 г. и имеющие тенденцию к продолжению в следующем году. В настоящее время в мировой экономике имеются повышенные инфляционные ожидания.

Рост цен на полупроводниковые товары повысит цены не только на электронику, но и на все сопутствующие товары, т. к. полупроводники давно стали параллельным отражением влияния нефти на мировое ценообразование. Однако, несмотря на гораздо более высокую диверсификацию производства и поставок полупроводниковой продукции в сравнении с нефтью, мир не избавился от тех проблем, которые появились с дефицитом и ростом цен электроники в минувшем году.

Это лишнее свидетельство, насколько важна роль полупроводниковой отрасли для мировой экономики. Непонятно и то, как будет развиваться ситуация с пандемией еще не побежденного коронавируса, способной оказать существенное влияние на мировую экономику. Поэтому любые долгосрочные прогно-

зы носят условный характер и зависят от многих причин. Такие «качели» и резкое изменение цен то в одну, то в другую сторону не идут на пользу мировой электронной промышленности и осложняют ее поступательное развитие с предсказуемым изменением цен. После «золотого дождя» высоких цен наступит спад, к которому много компаний будет не готово.

ЗЕЛЕНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ДЕФИЦИТ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ КРЕМНИЕВЫХ ФАБРИК

Почему TSMC и Intel принимают решение о строительстве водозависимых производств чипов в одном из самых засушливых штатов США – Аризоне? В настоящее время, когда климат Аризоны стал меняться и продолжает усугубляться водяной кризис, будущее некоторых важнейших водоносных горизонтов штата остается неопределенным.

По данным Национального центра климатических данных NOAA, за период 1970–2000 гг. в Аризоне выпадало в среднем всего 13,6 дюйма осадков в год, что делает ее четвертым по засухе штатом в стране. И, наоборот, Гавайи и Луизиана зарегистрировали за тот же период самые высокие уровни среднегодовых осадков в США, составившие 63,7 дюйма и 60,1 дюйма, соответственно. Вода – ключевой элемент в полупроводниковом производстве, но инфраструктура, которая была создана в Аризоне для обеспечения адекватных поставок и удовлетворения текущих потребностей отрасли, предусматривает, что заводы по производству микросхем обязательно рециркулируют воду для повторного применения.

Стремясь улучшить положение дел с использованием воды в Аризоне, Intel профинансирует 15 проектов по ее восстановлению, направленных на благо штата. «После полной реализации эти проекты помогут ежегодно восстанавливать примерно 937 млн галлонов воды», – заявила компания. Таким образом, нехватка воды не является препятствием для строительства заводов по производству чипов. Intel присутствует в Аризоне более 40 лет, и в этом штате существует хорошо развитая экосистема полупроводников.

В настоящее время в Intel работает более 12 тыс. человек в Аризоне. В этом штате находится новейшее производственное предприятие Intel – Fab 42. К другим крупным компаниям по производству микросхем, представленным в Аризоне, относятся ON Semi, NXP и Microchip. Благодаря обильному солнечному свету Аризона также обладает надежной, обильной и экологически чистой возобновляемой электроэнергией. При закладке двух новых заводов Intel подчеркивалось, что они на 100% будут использовать именно возобновляемую электроэнергию.

В Аризоне отсутствуют сейсмические риски, а также другие угрозы, например пожары и ураганы, в отличие от, например, шт. Орегона, где расположен один из заводов Intel. Но в штате создана хорошая экосистема за счет того, что местные университеты готовят кадры не только для производителей чипов, но и для смежников по всей цепочке поставок, а местные власти предоставляют хорошие льготы на стоимость земли, жилья и налоги. Тем самым они стимулируют строительство заводов смежников и поставщиков материалов для двух чиповых гигантов, т. е. сразу предусматривают локализацию.

TSMC также давно занимается регенерацией и повторным использованием водных ресурсов. В 2020 г. эта компания запустила программу строительства завода по переработке воды TSMC STSP – первого частного предприятия по переработке воды на Тайване [33]. Исходя из начальной суточной мощности рециркуляции 5 тыс. куб. м воды, к 2023 г. запланировано регенерировать 20 тыс. куб. м в сутки. Но, несмотря на это, проблема на острове остается острой. К тому же, она усугубилась за счет небывалой засухи 2021 г. Согласно Water Technology, производственное предприятие потребляет от двух до четырех миллионов галлонов (1 галлон = 3,785 л)

в день на очистку кремниевых пластин и охлаждение оборудования [34]. Задача TSMC – довести уровень регенерации используемой воды до 90% и коэффициент использования до 350% на каждую каплю воды. Эти принципы TSMC закладывает как основу своих подходов при строительстве новых заводов за пределами Тайваня и, в частности в Аризоне. Зеленое производство, управление энергетикой и утилизация отходов, контроль над загрязнением воздуха являются типовым стандартом для TSMC.

Программы регенерации воды и зеленой энергетики очень важны не только для полупроводниковой промышленности и всей мировой экономики, но и для жизни людей, особенно в регионах, испытывающих недостаток водных и энергетических ресурсов.

Европейский полупроводниковый центр IMEC, имеющий собственную линию полупроводникового производства, запускает исследовательскую программу в области устойчивых полупроводниковых технологий и систем (Sustainable Semiconductor Technologies and Systems, SSTS), направленную на исследование влияния всей производственно-сбытовой цепочки создания полупроводников для снижения воздействия на окружающую среду [35]. В рамках этой программы будет проведена оценка влияния на окружающую среду всех этапов и операций полупроводникового производства.

Центр IMEC также готов выполнить экспертизу производства заказчиков с предоставлением подробной экологической карты и рекомендаций по снижению выбросов и уровня загрязнений по каждой из этих операций. Сложность и важность такой работы связана с тем, что обилие операций производственного цикла микросхем, использующих разные физические и химические принципы, может приводить к самым разнообразным загрязнениям водных ресурсов и окружающей среды. Очевидно, что запрос на такие работы будет только расти. Первой компанией, которая присоединилась к программе, стала Apple [36]. Это не удивительно, поскольку, согласно исследованиям IMEC, цепочка производства мобильной техники и ее комплектующих является одной из самых загрязняющих в электронике.

ОТКАЗ ОТ ЗАКОНА МУРА ОТКЛАДЫВАЕТСЯ

В минувшем 2021 г. продолжилась технологическая гонка по освоению суперсовременных технологических процессов. Компании TSMC и Samsung расширяют объемы производства по техпроцессу 5 нм. В III кв. 2021 г. у TSMC в общем объеме 14,88 млрд долл. доля заказов по 5-нм технологии составила 18%, а по 7 нм – 34%. Эти показатели в дальнейшем будут увеличиваться [37]. Начиная с техпроцесса 3 нм, продолжится тактическое противостояние двух главных соперников – TSMC и Samsung – по отказу от классической FinFET-структуры транзисторов и переходу к новой структуре GAAFET. Особенности и различия этих технологий подробнее рассмотрены в [38].

Samsung еще в марте текущего года сообщила о создании образца чипа памяти 256 Мбит SRAM по новому типу технологии 3 нм MBCFET (GAAFET). Особенностью этой конструкции являлось использование разной шириныnanoстраниц в шеститранзисторной ячейке SRAM, позволяющей улучшать время записи. В сравнении с 7-нм процессом, технология 3 нм MBCFET позволяет повысить быстродействие транзистора на 30%, снизить потребление на 50%, а плотность упаковки в смешанной форме (SRAM и логика) увеличить на 80% [39].

В апреле Samsung выпустила версию 0.1 правил проектирования PDK по этой технологии. Массовое производство чипов по первой версии 3-нм процесса запланировано на 1-ю половину 2022 г., а по 2-й версии – на 2023 г. На ранней стадии находится 2-нм техпроцесс, массовое освоение которого запланировано до 2025 г. [40].

Руководители Samsung заявили на пресс-конференции перед ежегодным мероприятием Foundry Forum, что их новая технология MBCFET – более дорогая в производстве, но компания будет стремиться уменьшить стоимость транзистора [41]. Руководители Samsung отмечают, что совместимость MBCFET с процессами FinFET означает, что инженеры могут использовать одни и те же производственные технологии и оборудование для этих двух технологий. Это, в свою очередь, ускорит разработку процесса и наращивание производства.

TSMC, главный конкурент Samsung в контрактном производстве микросхем, также утверждает, что разработка 3-нм техпроцесса идет по плану и массовое производство начнется во 2-й половине 2022 г. Поскольку TSMC использует структуру транзистора FinFET для своего 3-нм техпроцесса, полупроводниковым компаниям не потребуются новые инструменты проектирования и разработка новых IP.

Главными заказчиками TSMC по этому процессу являются Intel и Apple [42]. На текущий момент Intel работает с TSMC, по крайней мере, по двум 3-нм проектам, а именно по новым процессорам для ноутбуков и ЦОД. Intel намеревается обеспечить те объемы производства, которые пока невозможны на собственных мощностях компании. Массовое производство чипов запланировано не ранее конца 2022 г.

Если верить источнику, зарезервированные объемы производства Intel даже превышают объемы Apple. Это значит, что компания Intel, серьезно озабоченная рыночным давлением AMD, при новом главе Патрике Гелсингере радикально меняет тактику и стратегию, в т.ч. за счет использования обещанного аутсорсинга.

В июле в средствах массовой информации появились сообщения о том, что Intel покупает фаундри-компанию GlobalFoundries за 30 млрд долл. [43]. И хотя представители GlobalFoundries опровергли эту информацию, новая тактика главы Intel по организации в компании контрактного фаундри-бизнеса позволяет предположить, что работа в этом направлении может продолжиться в ближайшем будущем. Владельцы GlobalFoundries из ОАЭ давно готовы продать компанию.

TSMC начнет использовать технологию GAAFET для своих 2-нм процессорных направлений, запланированных на 2023 г. Таким образом, компания Samsung, которая по-прежнему сильно отстает от TSMC по доле рынка, пошла на большой технологический риск, перейдя на GAA на одно поколение раньше, чем тайваньский мегазавод.

Процесс 3 нм еще не освоен, но вокруг него уже начинает разворачиваться жесткая конкуренция между заказчиками, с одной стороны, и TSMC с Samsung, с другой. Основному заказчику Apple тайваньский гигант предоставляет максимальные преференции во всех сферах, включая цены.

При общем повышении цены на 20% для всех заказчиков, в отношении Apple она выросла только на 3% [44]. Такие заказчики как AMD и Qualcomm недовольны этим, опасаясь, что их заказы по технологии 3 нм будут изготавливаться по остаточному принципу или не будут приняты, если загрузка линии окажется полной. Возможно, они отдадут эти заказы в Samsung, что обеспечит последней хорошие стартовые условия по данной технологии.

В текущем году о своих амбициях в деле освоения новых суперсовременных технологий 3–4 нм заявил и американский процессорный гигант Intel, значительно отстающий от соперников. Intel запустит в производство свою версию GAA под названием RibbonFET в рамках процесса 20A, вероятно, в середине 2024 г. [45]. Intel также будет использовать свои транзисторы Enhanced SuperFin в процессе 4 нм Intel 4 в 2022 г. и процессе 3 нм Intel в 2023 г. Во всех этих новых технологиях (FinFET и GAA) применяется литография в жестком ультрафиолете (EUV). Заметим также, что ни Samsung, ни TSMC не решили последовать примеру Intel и изменить названия масштабов техпроцессов с нанометров на ангстремы, по крайней мере, пока.

Еще одним участником этой гонки является американская компания IBM. Несмотря на отсутствие своих производственных мощностей, IBM активно участвует в разработке передовых процессов GAA в рамках программы по разработке полупроводников в своей исследовательской лаборатории, находящейся в комплексе Albany Nanotech в Олбани (шт. Нью-Йорк).

Samsung является частью этой программы, и только в текущем году IBM добавила в программу Intel, руководство которой также решило привлечь IBM к ускорению освоения новых технологий в своей компании. Это может объяснить, почему и IBM, и Intel появились на мероприятии Samsung. Samsung также является производственным фаундри-партнером для последних платформ Power Systems и Telum Z компании IBM.

IBM представила первый в мире 2-нм чип, созданный в своем научно-исследовательском центре в Олбани [46]. В тестовой микросхеме используются транзисторы с круговым затвором GAA, построенные по технологии нанолистов IBM. В этом чипе каждый транзистор имеет три уложенных друг на друга нанолиста шириной 40 нм и высотой 5 нм. Шаг транзисторов составляет 44 нм, а длина затвора – 12 нм. Новый 2-нм техпроцесс будет использоваться практически в каждом приложении, начиная с мобильной электроники и заканчивая высокопроизводительными серверами и высоко-производительными вычислениями (HPC), включая AI, 5G, 6G, автономные системы, квантовые вычисления. Он также будет использоваться для собственных платформ IBM Power Systems и IBM Z, хотя эти устройства по-прежнему будут выпускаться Samsung – партнером IBM по производству.

Тестовый чип, представленный IBM, содержит около 50 млрд транзисторов. В целом, по заявлению IBM, новый техпроцесс увеличит производительность 2-нм чипов на 45% или уменьшит их энергопотребление на 75% по сравнению с современными 7-нм кристаллами. IBM также первой продемонстрировала тестовые чипы, выполненные по нормам 7 и 5 нм.

Гонка между Samsung и TSMC не замедлилась. Теперь в нее вступает Intel. Хотя Samsung не может быть первой компанией, которая начнет массовое производство по 3-нм процессу, но ее нового транзистора с круговым затвором GAA должны быть лучшие характеристики по сравнению с 3-нм FinFET у TSMC. Задача Samsung – сохранить лидерство после того, как TSMC развернет свой 2-нм процесс N2 с GAAFET в 2023 г., а Intel – свою технологию 20A с RibbonFET в 2024 г.

Противостояние между этими компаниями происходит не только в разработке новых технологий, но и в расширении производительности фабрик. Samsung заявила о том, что к 2026 г. планирует увеличить свои мощности в 3,2 раза, включая открытие новой фабрики в США. Samsung не сообщает местоположение, размер или сроки запуска производства американской фабрики, но она уже располагает предприятием S2 в Остине (шт. Техас). Южнокорейский гигант также рассматривает возможность масштабного расширения зрелых технологий, по которым ощущался текущий дефицит микросхем. TSMC взяла на себя обязательство построить новую фабрику в Фениксе (шт. Аризона) для процесса N4, а Intel подготовила почву для новой передовой фабрики в Чандлере (шт. Аризона).

В очередном интервью Пэт Гелсингер затронул тему закона Мура. По его утверждению, «...закон Мура жив и здоров. Мы прогнозируем, что в течение следующего десятилетия будем придерживаться этого закона или даже опережать его. Мы как проводники закона Мура будем неустанно стремиться к инновациям» [47]. Гелсингер указал на две новые разработки, которые помогут Intel догнать или даже обойти TSMC и Samsung. Первая из них – архитектура RibbonFET. В этой конструкции используются четыре затвора для управления током, текущим через транзисторы. Вторая разработка называется PowerVia. Она касается внутренних соединений. Технология позволяет транзисторам потреблять электроэнергию с одной стороны микросхемы,

используя другую сторону для подключения к каналам передачи данных.

Сегодняшние конструкции микросхем содержат транзисторы, которые пытаются выполнять обе функции с одной и той же стороны, что сокращает возможности разработчиков упростить процесс, а также ограничивает миниатюризацию. С учетом всех наработок, считает глава Intel, компания догонит TSMC и Samsung уже в 2024 г. и обойдет их в 2025 г.

Сложно прогнозировать, насколько успешными окажутся достижения Intel, но еще недавно до прихода Гелсингера в компанию казалось, что она безнадежно отстала в технологиях от конкурентов. Пока что результаты компании не вызывают оптимизма. По прогнозу IC Insights, Intel вместе с японской Sony будут единственными среди первых 25 мировых компаний, объемы продаж которых снизятся относительно 2020 г. (1% и 3%, соответственно) [48]. У Sony, в отличие от Intel, падение связано с сокращением выпуска игровых консолей из-за мирового дефицита микросхем. Лидером с ростом 65% станет процессорный конкурент Intel – компания AMD. В III кв. 2021 г. Intel осуществила первые отгрузки клиентам продукции по новому бизнесу Intel Foundry Service, на который компания возлагает большие надежды.

На рисунке 5 приведены расчетные показатели плотности транзисторов на 1 мм² для техпроцессов 16–3 нм, представленные WikiChip [49]. Плотность транзисторов, изготовленных по техпроцессу 5 нм, увеличивается на 87% (по оценке TSMC, – на 84%) в сравнении с процессом N7, а для технологии 3 нм относительно 5 нм – на 70%. Таким образом, плотность транзисторов, изготовленных по 3-нм процессу, достигнет почти 300 млн/мм², хотя у не так давно освоенной технологии 16 нм этот показатель составил «всего» 28,88 млн/мм².

Европейская компания ASML, монопольный производитель литографического EUV-оборудования, оптимистично заявляет, что ее оборудование с увеличенной числовой апертурой с 0,33 до 0,55 NA, которое она планирует поставлять с 1-й половины 2023 г. для технологии 2 нм, продлит действие закона Мура как минимум на 10 лет [50].

Еще одним средством повышения степени интеграции в корпусе, а не в кристалле, являются новые сборочные технологии, применяемые не только OEM-производителями, но и фаундри-компаниями с использованием чиплетов, плиток, 2,5D и 3D сборочных процессов. Samsung относит эти варианты упаковки к диапазону вне действия закона Мура для гетерогенной интеграции. Компания предложит 3D ИС, микробампы, гибридный монтаж и варианты 3,5D, чтобы идти в ногу с Intel и TSMC. TSMC имеет большой план стратегического развития и опыт работы по сборке со своими технологиями CoWoS, InFO и SoIC. Эта компания сделала сборку главной темой выступлений на своем недавнем саммите по технологиям. Технологии Intel Foveros и EMIB также преподносятся как отличительная особенность компании.

Три года назад в декабре 2018 г. во время презентации стратегического плана развития технологии 10 нм и сборочных процессов Intel главный архитектор компании Раджа Кодури (Raja Koduri) предположил, что отрасль вступает в ту эпоху, когда потребуются инновации во всей архитектуре системы, чтобы обойти ограничения законов физики. Большая часть улучшения системной архитектуры обеспечивается технологическим процессом. Intel обычно имеет два технологических варианта.

Один процесс оптимизирован под производительность вычислений, а другой – под системы ввода/вывода и системы-на-кристалле (СнК). Технологические процессы, в т. ч. по вине компаний Intel, TSMC и др., постоянно хваствующихся повышением плотности транзисторных ячеек, представляют как средство создания однородных транзисторов. На самом деле, архитектура транзисторов различается у высокопроизводительных процессоров, ПЛИС, и они

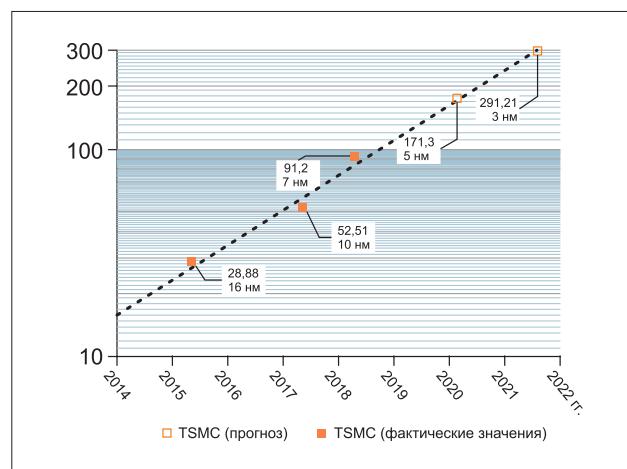


Рис. 5. Повышение количества транзисторов на 1 мм² для 16–3-нм процессов TSMC

имеют разные показатели соотношения производительности/мощности в сравнении с транзисторами для графических процессоров, энергоэффективных ПЛИС и требуют разных техпроцессов. Это позволяет проводить разработку отдельных чиплетов и сборку крупных ИС из более мелких чипов, изготовленных по разным технологиям. Ключевой особенностью сборочной технологии Foveros является встречная (face-to-face, F2F) вертикальная двухкристальная компоновка через шариковые микровыводы с очень мелким шагом 36 мкм (чаще всего, с использованием медных контактных столбиков) (см. рис. 6а–б) [51].

Foveros – сложная сборочная технология, которая создана благодаря большому сборочному опыту Intel как OEM-производителя. Ее основными преимуществами являются повышение плотности и уменьшение паразитных параметров межсоединений, что необходимо высокопроизводительным приложениям подобным тем, которые используются Intel. В этой технологии один логический чип устанавливается на другой вне кристалла памяти или несколько чипов – поверх базового логического чипа.

Каждая из этих сборочных технологий имеет свои особенности, но все они совместно с новыми суперсовременными техпроцессами производства чипов позволяют повысить степень интеграции и поддержать следование закону Мура не только в рамках стратегии More Moore (период времени, когда закон Мура еще работает), но и More than Moore (новая область микро-, наноэлектронных и других устройств, не связанная с собственно миниатюризацией полупроводников). Таким образом, отказ от следования закону Мура, гласящего об удвоении количества элементов каждые два года, который предсказывался вначале на техпроцессе 28 нм, а затем на 14 нм, откладывается до худших времен в полупроводниковой микроэлектронике. К счастью, они пока не наступили.

МИКРОЭЛЕКТРОНИКА СТАЛА СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛЬЮ

Все действия и решения руководства ведущих мировых стран и корпораций в 2020–2021 гг. четко показывают, что полупроводниковая отрасль является стратегической не только в экономической, но и в политической сферах. Это было понятно еще после принятия США после Второй мировой войны программы КОКОМ по ограничению поставок в СССР стратегических товаров. К ним относился довольно широкий перечень товаров, и не только электронных. В то время в программе участвовало 17 государств.

В 1994 г. после перестройки в СССР эта программа прекратила свое существование. После исчезновения двуполярного мира и разпада СССР США как самая крупная мировая эконо-

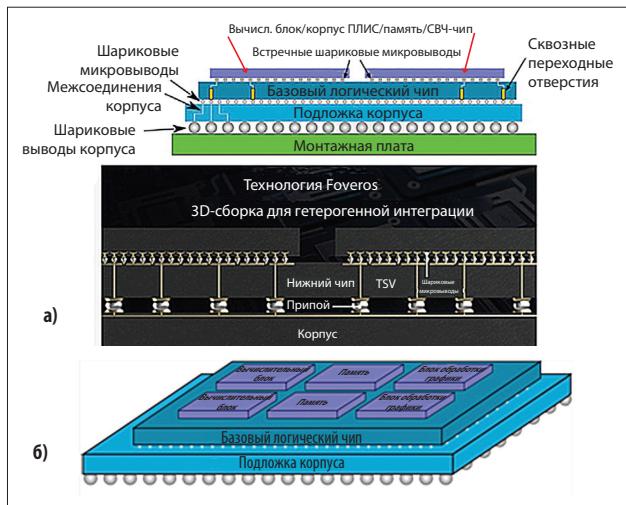


Рис. 6. а) 3D-сборка Foveros компании Intel; б) пример компоновки разных чипов

ника решает эти вопросы самостоятельно. Наиболее отчетливо это проявилось в санкциях, наложенных на предприятия электронной промышленности Китая и России. Но если российская электронная промышленность не является стратегической в отечественной промышленности, то в Китае она относится к базовой и стратегической, определяющей нынешнее лицо нового Китая. Удар по ней – лучшее средство для экономического торможения Поднебесной. И США это прекрасно понимают.

В 2021 г. санкционная война между США и Китаем несколько утихла. Этому способствовали две причины. Во-первых, тотальный дефицит электронных компонентов, значительная часть которых производится в Китае и экспортится в США, вследствие чего страдает сама американская экономика. Многие автопроизводители США, ранее закупавшие автоэлектронику в Европе, Японии и Южной Корее, после возникновения дефицита были вынуждены переключиться на поставки из Китая. Во-вторых, как и прогнозировалось, смена администрации в Белом доме, избрание президентом Джона Байдена, большинство демократов в Конгрессе и Сенате снизили уровень конфронтации между двумя странами.

Подтверждением этого служит выдача 321 лицензии на сумму 103 млрд долл. американским компаниям на поставки полупроводниковой продукции и разных компонентов китайским компаниям Huawei и SMIC, находящимся под санкциями [52]. При этом республиканцы не успокоились – они будут использовать любую возможность для возобновления и продолжения санкционной войны.

Доля Евросоюза снижается в мировом полупроводниковом производстве в течение последних 10 лет. Если в 2003–2004 гг. она составила около 12%, то с 2009 г. этот показатель снизился до 8–9% [53], что вызывало обеспокоенность руководства Евросоюза, но не сопровождалось практическими и результативными решениями по этой проблеме.

В Европе имеются мощные мировые исследовательские институты IMEC (Бельгия), LETI/CEA (Франция), Фраунгофер (Германия) по выполнению НИОКР по самым передовым полупроводниковым направлениям, но отсутствуют самые современные производства кристаллов по 5–7-нм технологиям. Кроме того, Европа стала в значительной мере зависеть от производства кристаллов в Азии и в т. ч. в Китае. Санкции США против Китая и ограничения на использование американского оборудования привели к усилению регионализации и нарушению цепочек международных поставок, что окончательно убедило руководство Европы

в необходимости обеспечения технического и технологического суверенитета и независимости.

Декларация под названием «Закон о европейских чипах» (которое копирует американский вариант документа) была провозглашена президентом Европейской комиссии Урсуло фон дер Ляйен в обращении к государствам Евросоюза 15 сентября 2021 г. [54]. «Мы зависим от современных микросхем, производимых в Азии. Это не только вопрос нашей конкурентоспособности, но и технологического суверенитета» – заявила фон дер Ляйен. Европейская инициатива предусматривает развитие мегафабрик, способных масштабировать и наращивать объемы производства микросхем, начиная с 2-нм процесса.

Энергоэффективные ИС – еще один приоритет, поскольку рынок электромобилей набирает обороты по всей Европе. Однако самостоятельно без привлечения и помощи мировых технологических гигантов Евросоюз не сможет решить эту задачу. Раунд переговоров с TSMC завершился безрезультатно. Теперь основные надежды у Европы – на компанию Intel, глава которой подтвердил желание построить в Европе мегафаб [55]. В течение ближайших 10 лет Intel планирует вложить около 80 млрд евро в расширение своего бизнеса в Европе. Однако для этого Intel самой придется сделать технологический рывок, т. к. в настоящее время процессорный гигант не располагает даже собственной фабрикой на 7 нм. Таким образом, эта задача на ближайшее десятилетие.

В мировой полупроводниковой электронике в 2021 г. обозначились две параллельные тенденции. Правительства передовых мировых стран озабочены необходимостью достижения национального суверенитета и независимости путем создания новых фабрик в своих странах во избежание проблем с поставками товаров из других мировых регионов. В то же время транснациональные компании стремятся расширить производственные возможности, сократить затраты и себестоимость производства за счет строительства заводов за пределами своих национальных границ. Компании делали это и прежде, но усиливающаяся в последние годы регионализация усложняет такое расширение. Еще в 2019 г. на фоне санкций США казалось, что национальный суверенитет и регионализация в производстве необратимы.

Однако мировая пандемия и тотальный дефицит электроники, негативно отразившиеся на многих отраслях мировой экономики, изменили ситуацию и потребовали резкого увеличения полупроводникового производства. В связи с этим фактор суверенитета отошел на второй план, но не исчез: правительства многих стран начали соревноваться в представлении инвестиций и льгот крупным транснациональным компаниям для создания полупроводниковых фабрик на своих территориях.

Заметим, что эта тактика пока успешно работает. Однако это временное перемирие, которое может закончиться, когда текущий ажиотаж спадет и американцы получат на своей территории мегафабрики. В то же время противостояние с Китаем никуда не исчезнет, и США снова будут готовы прибегнуть к функциям мирового законодателя. Некоторые текущие действия властей США и Китая подтверждают это.

Власти США по-прежнему призывают американских производителей переносить предприятия из-за рубежа в свою страну, издают распоряжение о создании запасов продукции, оборудования, сырья для оборонного сектора, а китайские власти на фоне дефицита электроники призывают к созданию внутренней безопасной и контролируемой цепочки поставок с предоставлением приоритета китайским компаниям и отказом зарубежным. От этих действий проблема дефицита электроники только усиливается. Стремление локализовать производство электронных

автокомпонентов в США подтверждает также стратегическое соглашение между Ford и GlobalFoundries о выпуске последней многофункциональных микросхем для линейки автомобилей Ford [56].

Впрочем, опасность этой гонки государственных субсидий полупроводниковым компаниям уже начинают замечать, и из Евросоюза доносятся призывы к США ограничить их, поскольку за это придется платить американским и европейским налогоплательщикам, которым эти инвестиции сулят очень малую выгоду [57].

В увлечении полупроводниковых грандов массовым строительством новых фабрик действительно есть риски. Серьезное торможение мировой экономики в силу разных причин неминуемо отразится на электронной промышленности, а создание инвестиционного «пузыря» может привести к тем же последствиям, что и ипотечный «пузырь», ставший спусковым крючком для мирового экономического кризиса в 2008–2009 гг.

Хотя эти две ситуации отличаются, следует учитывать, что предыдущий мировой кризис появился из-за ипотечного «пузыря» в одной стране, тогда как в настоящее время много стран накачивает электронную промышленность большими деньгами. Остается надеяться, что риски для отрасли диверсифицируются тем, что она во время мировых кризисов сокращается намного слабее и восстанавливается быстрее мировой экономики, чему мы неоднократно были свидетелями все последние десятилетия. Однако эффект триггера от этого не исчезает.

ВЫВОДЫ

1. Опустошение складов производителей и потребителей электронных компонентов (ЭК) во время мировой пандемии COVID-19, резко взросшая потребность в ЭК после возобновления работы и ажиотажный спрос создали в 2021 г. ранее небывалый дефицит электронных компонентов, крайне отрицательно сказавшийся на многих отраслях мировой экономики и, в первую очередь, на автомобильной промышленности.
2. Мировая полупроводниковая отрасль не справилась с возросшими заказами, которые привели к некоторым последствиям. К положительным последствиям следует отнести увеличение объемов производства и поставок компонентов, материалов, оборудования, строительство и запуск новых заводов, а к отрицательным – значительное увеличение сроков поставок, рост цен, отказы и введение предоплаты за заказы, что прежде массово не практиковалось.
3. Мировые поставки полупроводников в 2021 г. на фоне их дефицита во всех сегментах продукции и регионов стремительно увеличиваются на 25,1% до 550 млрд долл. относительно 2020 г. и впервые в истории отрасли превзойдут рубеж в 500 млрд долл.
4. Прогнозы мирового полупроводникового рынка на ближайшие пять лет положительные и оптимистичные. Некоторые компании ожидают достижение рынком к 2026 г. невероятных показателей в 778 млрд долл. Однако, по другим прогнозам, в 2023–2024 гг. возможно перепроизводство, затоваривание складов и временное падение мирового полупроводникового рынка. Но оно не отразится на снижении рынка контрактных услуг и продукции по суперсовременным технологиям 3–5–7–10 нм из-за отсутствия достаточных конкурентных предложений от ограниченного количества таких компаний на рынке.
5. Увеличение спроса на продукцию по относительно недорогому и востребованному для многих изделий техпроцессу 28 нм на пластинах диаметром 300 мм без использования транзисторных структур FinFET приведет к запуску новых фабрик и переводу производства с технологии 40 на 28 нм и с пластин диаметром 200 на 300 мм.
6. Крупные полупроводниковые гранды для увеличения производительности фабрик инвестируют огромные средства в строительство новых 300-мм предприятий в своих странах и за их пределами, что вызывает озабоченность некоторых стран и опасность создания инвестиционного «пузыря».
7. 2019–2021 гг. еще раз продемонстрировали, что полупроводниковая промышленность является стратегической как в экономической, так и в политической сфере, способной не только оказать сильное влияние на многие отрасли мировой экономики, но и за счет санкций, ограничений или преференций быть оружием политического воздействия даже на страны с крупной экономикой.
8. Бурный рост мирового полупроводникового рынка и создание новых производств четко обозначили дефицит кадров для полупроводниковой промышленности и рост спроса на них во всех мировых регионах. Это плохой знак для России, поскольку дефицит приведет к новому оттоку за рубеж наиболее квалифицированных и мобильных специалистов, недостаток которых испытывает и наша страна.
9. Значительный дефицит электронных компонентов всех типов спровоцировал не только рост их цен до 50%, но и повышение цен на все сопутствующие материалы и услуги. Эта тенденция продолжится в 2022 г. и вместе с увеличением цен на нефть, газ, металлы, древесину и т. д. окажет заметное влияние на рост общемировой инфляции.
10. Запросы общества на зеленую энергетику и высокое потребление воды фабриками производства чипов привели к необходимости регенерации, повторного использования водных ресурсов и финансированию этих проектов мировыми полупроводниковыми гигантами. В результате появилась возможность построить п/п фабрики в засушливых регионах. Кроме того, местные власти могут применить эти технологии для бытовых нужд населения.
11. В 2021 г. продолжилось пока не выявившее победителя тактическое противостояние компаний TSMC и Samsung, которые выбрали разную архитектуру транзисторов (FinFET и GAAFET) для 3-нм процесса. 2022–2023 гг. покажут, оправдан ли риск Samsung, сделавшей ставку на новую архитектуру MBCFET (GAAFET), чтобы обогнать конкурента.
12. Конкурентная борьба компаний TSMC, Samsung, Intel при активном техническом участии IBM за освоение суперсовременных технологий 1–3 нм в сочетании с новыми процессами 3D-сборки обеспечат следование закону Мура в полупроводниковой микроэлектронике в ближайшие годы.
13. В 2021 г. сохранился подход государств с сильной экономикой к регионализации производства электроники и обеспечению национального суверенитета. Однако сильный дефицит электронных компонентов, необходимость быстрого увеличения их выпуска и стремление извлечь из него максимальную пользу, снизить себестоимость производства, привлечь инвестиции и софинансирование государств привели к усилению тенденций по строительству новых заводов транснациональными компаниями за пределами их национальной прописки.
14. Несмотря на все намерения руководства Евросоюза, обеспокоенного падением его доли в мировой отрасли, построить в Европе суперсовременную фабрику на 7 нм и менее, шансы на ее реализацию после проваленных переговоров с TSMC в ближайшие годы невелики. В среднесрочной перспективе – надежды только на компанию Intel, подтвердившей такие планы.

15. Дефицит электронных компонентов и победа демократов на выборах в США способствовали ослаблению санкционной войны между США и Китаем и положительно отразились на мировом полупроводниковом рынке.

ЛИТЕРАТУРА

1. *The Worldwide Semiconductor Market is expected to show an outstanding growth-rate of 25.1 percent in 2021.* WSTS. San Jose. California. August 16. 2021//www.wsts.org.

2. *Semiconductor Market to Grow By 17.3% in 2021 and Reach Potential Overcapacity by 2023.* IDC Reports. September 19. 2021//www.idc.com.

3. *Surges Seen in Sensors and Discrete Semiconductors This Year.* IC Insights. October 26. 2021//www.icinsights.com.

4. Немецкие автомобильные компании разоряются из-за нехватки чипов. Российские также пострадали. Geekville. 01.11.2021//www.geekville.ru.

5. Глава Apple оценил потери компании от сбоя в поставках чипов в 6 млрд долл. Forbes. 29.10.2021//www.forbes.ru. 6. Shortages related to semiconductors to cost the auto industry \$210 billion in revenues this year, says new AlixPartners forecast. September 23. 2021//www.alixpartners.com.

7. *The Wait for Semiconductors Turns Ominous for Automakers.* Bloomberg. October 07. 2021//www.bloomberg.com.

8. Сайт TSMC//www.tsmc.com.

9. *Chinese foundry pushes 300mm IGBT production.* eeNews Automotive. July 31. 2020//www.eenewsautomotive.com.

10. *Shift from 8" Wafer Fabs to 12" Could Ease IC Shortages.* EETimes. May 18. 2021//www.eetimes.com.

11. *Global Silicon Wafer Shipments Projected to Log Robust Growth Through 2024.* SEMI Reports. SEMI. October 18. 2021//www.semi.org.

12. *Highlights of the September 2021/Q3 Edition of the Fab Databases.* SEMI. September 01. 2021//www.semi.org.

13. *Foundry Revenue Expected to Increase by 23.8% YoY in 2020, with Advanced Nodes and 8-Inch Capacities Being Key to Industry Competitiveness in 2021.* TrendForce. November 18. 2020//www.trendforce.com.

14. *Semiconductor Market Report: Trends, Forecast and Competitive Analysis.* ReportLinker. August 2021//www.reportlinker.com.

15. *IC Insights Forecasts a 21% Surge in IC Unit Shipments This Year.* IC Insights. July 28. 2021//www.icinsights.com.

16. TSMC website//www.tsmc.com.

17. *Exclusive TSMC looks to double down on U.S. chip factories as talks in Europe falter.* Reuters. May 14. 2021//www.reuters.com.

18. *Japan readies multiyear support package for TSMC's new chip plant.* Nikkei Asia. October 21. 2021//asia.nikkei.com.

19. *TSMC Annual Reports Third 2010.* TSMC//www.tsmc.com.

20. *TSMC Reports Third Quarter 2021.* TSMC. October 14. 2021//www.tsmc.com.

21. У Intel колоссальная проблема с кадрами. Процессоры производят вчерашие школьники. CNews. 6.10.2021//www.cnews.ru.

22. Основатель TSMC: возрождение национальной полупроводниковой промышленности будет не по карману США. 3D News. 27.10.2021//www.3dnews.ru.

23. *TSMC to build new fab in Japan together with Sony.* Evertiq. November 09. 2021//evertiq.com.

24. *TSMC: How a Taiwanese chipmaker became a linchpin of the global economy.* Financial Times//www.ft.com.

25. *Micron Announces Over \$150 Billion in Global Manufacturing and R&D Investments to Address 2030 Era Memory Demand.* October 20. 2021//investors.micron.com.

26. *Texas Instruments to buy Micron's Utah factory for \$900 million.* Reuters. June 30. 2021//www.reuters.com.

27. *Micron вбухает в расширение производства чипов 150 млрд долл.* Время электроники. 22.10.2021//russianelectronics.ru.

28. *Texas Instruments closing two fabs, building one.* eeNews Analog. February 06. 2020//eenewsanalog.com.

29. *TI might not be done with Sherman.* Evertiq. October 07. 2021//evertiq.com.

30. *Texas Instruments to begin construction next year on new 300-mm semiconductor wafer fabrication plants.* DALLAS, November 17. 2021//news.ti.com.

31. Глава Infineon: цены на чипы сильно вырастут – деньги нужны на расширение производств. 3D News. 17.09. 2021//www.3dnews.ru.

32. Производители чипов столкнулись с резким ростом цен на кремниевые пластины. 3D News. 16.11.2021//3dnews.ru.

33. *Green Manufacturing.* TSMC//www.tsmc.com.

34. *Water Management Innovation is Central to the Future of ICs.* EETimes. July 30. 2021//www.eetimes.com.

35. *Sustainable Semiconductor Technologies and Systems.* Imec//www.imec-int.com.

36. *Apple joins as first public partner in new Imec research program that helps entire semiconductor value chain reduce its ecological footprint.* IMEC. October 28. 2021//www.imec-int.com.

37. *TSMC Reports Third Quarter 2021.* TSMC. October 14. 2021//www.tsmc.com.

38. Боднарь Д. Полупроводниковая микроэлектроника – 2020. Часть 3. Марафонская полупроводниковая гонка к 1 нм//Электронные компоненты. № 2. 2021.

39. Samsung представил 3-нм чип 256-Мбум SRAM. Время электроники. 16.03.2021//russianelectronics.ru.

40. *From FinFET to GAA: Samsung's fab journey to 3 nm and 2 nm.* EDN. October 11. 2021//www.edn.com.

41. *Samsung Foundry Promises Gate All-Around in '22.* EETimes. October 14. 2021//www.eetimes.com.

42. *Apple and Intel become first to adopt TSMC's latest chip tech.* Nikkei Asia. July 2. 2021//asia.nikkei.com.

43. *Intel Is in Talks to Buy GlobalFoundries for About \$30 Billion.* The Wall Street Journal. July 15. 2021//wsj.com.

44. Тесное сотрудничество TSMC и Apple заставило AMD задуматься о выборе Samsung в качестве производителя чипов. 3DNews. 21.11.2021//www.3dnews.ru.

45. *Intel Announces 20Å Node: RibbonFET Devices, PowerVia, 2024 Ramp.* WikiChip Fuse. July 26. 2021//fuse.wikichip.org.

46. *IBM Unveils World's First 2 Nanometer Chip Technology, Opening a New Frontier for Semiconductors.* IBM Newsroom. May 06. 2021//ibm.com.

47. *Intel will outpace Moore's Law, CEO Pat Gelsinger says.* Cnet. October 27. 2021//www.cnet.com.

48. *Annual Revenue Growth to Skyrocket among Top 25.* IC Insights. November 17. 2021//www.icinsights.com.

49. *TSMC Ramps 5nm, Discloses 3nm to Pack Over a Quarter-Billion Transistors Per Square Millimeter.* WikiChip Fuse. April 17. 2020//fuse.wikichip.org.

50. *Moore's Law Could Ride EUV for 10 More Years.* EETimes. September 30. 2021//www.eetimes.com.

51. *Intel Looks to Advanced 3D Packaging for More-than-Moore to Supplement 10-and 7-Nanometer Nodes.* WikiChip Fuse. December 22. 2018//fuse.wikichip.org.

52. США выдали лицензии на поставки чипов и компонентов для Huawei и SMIC на десятки миллиардов долларов, несмотря на санкции. 3D News. 22.10.2021//www.3dnews.ru.

53. *Semiconductor Industry Association (SIA) Factbook 2019.* www.semiconductors.org.

54. *2021 State of the Union Address by President von der Leyen.* An official website of the European Union. September 15. 2021//ec.europa.eu.

55. *Intel to invest up to 80 bln euros in boosting EU chip capacity.* CEO. Reuters. September 07. 2021//www.reuters.com.

56. *GlobalFoundries, Ford to Address Auto Chip Supply and Meet Growing Demand.* Ford Media Center. November 18. 2021//media.ford.com.

57. *U.S., EU must avoid subsidy race amid chip shortage – EU's Vestager.* Reuters. November 13. 2021//www.reuters.com.

См. окончание в следующем номере.